(19)日本国特許庁 (JP)

(12) 特許 公 報(B2)

(11) 特許出顧公告母号

特公平7-112083

(24) (44)公告日 平成7年(1995)11月29日

(51) Int.CL*

類別配号

庁内監理番号

PΙ

技術表示會所

H015 3/094

HO1S 3/094

S

前塚項の数1(全 3 頁)

(22)出鎖日	平成2年(1990) 6月14日	新日本製銀株式会社
		京京都千代田区大手可2丁目6番3号
		(72)発明者 山口 哲
(65)公問番号	铃閂平4 -48664	神奈川県相模原市淵野辺5-10-1 新日
(43)公陽日	平成4年(1992)2月18日	本製鐵株式会社第 2 技術研究所內
		(72)発明者 今非 浩文
		神奈川県相模原市制野辺5-10-1 新日
		本製鐵株式会社第 2 技能研究所内
		(74)代理人 弁理士 田北 漢暗
		容數官 尿光明
		(56)参考文献 特別 平2-54982 (JP, A)
		実開 昭60-75307 (JP、U)

(54) 【発明の名称】 アレイ半導体レーザ網面励起回体レーザ

【特許請求の範囲】

【請求項!】アレイ半導体レーザ出力を集光し固体レー **ヴ素子を光励起するアレイ半導体レーザ励起固体レーザ** において、分布屈折率レンズをアレイ半導体レーザの各 ストライプに対応して並べ、アレイ半導体レーザ出力を 集光してコリメートするレンズアレイと、コリメートさ れた各ストライプ光を一括して集光して一箇所に重ね台 わせ、個体レーザ漢子を端面励起するためのフォーカシ ングレンズとして用いる第2のレンズと、からなる光緒 台器を備えたことを特敵とするアレイ半導体レーザ蝗面 19 歳を実現できる。 励起団体レーザ。

【発明の詳細な説明】

[産業上の利用分野]

本発明は、端面光源としての半導体レーが出力を高効率 で光結合し、固体レーザ素子を光励起する半導体レーザ

励起固体レーザに関するものである。

[従来の技術]

半導体レーザを励起光源として用いた固体レーザが、高 効率、長寿命、小型化が図れることから、注目を集めて いる。半導体レーザ励起団体レーザにおける、団体レー ザの光輪方向から光励起する總面励起方式(例えば特別 超58-52889号参照)では、固体レーザの発振の空間を ードに半導体レー労出力光による励起空間をうまくマッ チングさせることにより、高効率で単一基本衛モード発

[発明が解決しようとする課題]

半導体レーザはビーム発散角が大きいため集光系を半導 体レーザに接近して集光する必要があり発振光の集光は 容易ではない。半導体レーザ励起固体レーザの高出力化 のためには、励起用の半導体レーザを高出力化する必要

がある。半導体レーザはストライブ状の活性層からレー ザ光が開射するが、単一のストライプレーザでは出力に 服界があり、これ以上の出力を得るためには、複数のス トライプを並べたアレイ状にしなければならない。

このようなアレイ半導体レーザを励起光源として用いよ うとすると、アレイの幅は1cm程の長さに渡るので、通 窓のレンズ系を用いて複数ビームを1つのスポット状に 綾り込むことは到底できないため励起効率の良い端面励 起方式が採用できず、側面脳起方式にしか適用できなか (1989) ;M.K.Reed,W.J.Kozlovsky,R.L.Byen,G.L.Harna gel,and P.S.Cross,Opt.Lett.,13,204(1988)等參 麗)。

|本発明は、かかる状況に鑑みてなされたもので。マルチ ストライプのアレイ半導体レーザから出る発散角が大き い多数の複数ビームを集光し、個体レーザの発振の空間 モードに半導体レーが出力光による励起空間をマッチン グするように、効率よく固体レーザ出力光を生起せしめ る半導体レーザ励起固体レーザを提供することを目的と さる。

[課題を解決するための手段]

上記の目的を達成するために、この発明の手段として、 アレイ半導体レーが出力を集光し固体レーザ素子を光励 起するアレイ半導体レーザ励起関体レーザにおいて、分 **布屈折率レンズをアレイ半導体レーザの各ストライブに** 対応して並べ、アレイ半導体レーザ出方を集光してコリ メートするレンズアレイと、コリメートされた各ストラ イブ光を一括して集光して一箇所に重ね合わせ、固体レ ーザ素子を鑑面励起するためのフォーカシングレンズと して用いる第2のレンズと、からなる光結合器を構える。 ものである。

[作用]

半導体レーザ励起固体レーザの錆モードの特性は、總面 励起方式の場合、固体レーザ素子内の光励起空間の形状 で挟まる。このため、単一基本譜モードを得るために は、絞った励起光の強度分布をなるべくガウス分布に近 づけ、個体レーザ素子内に一定の大きさのピームスポッ トを安定的に作ってやることが好きしい。

半導体レーザ励起固体レーザの光結合器として屈折率が 卓心軸から外周面に向かって放射線状に分布して異なっ ている円柱状の光学ガラス体である分布屈折率レンズを 用いると発散角の大きい半導体レーザ光を容易に集光す ることができる。

このような特性を持つ分布屈折率レンスを用いて各スト ライブからのレーザ光を集光できることを利用し、アレ

イ半導体レーザの各々のストライブからの出射光を、分 布屈新率レンズアレイで集光し、第2のレンズで全体光 を一つのビームスポットに絞ってやり固体レーザ素子を 励起すれば、高品質の衛モード光が得られる。

「実験例)

以下、実施例に基づいて本発明を説明する。

第1図はアレイ半導体レーザ光を集光し固体レーザ素子 を端面励起する団体レーザの模式図である。第1回に示 すごとく、固体レーザ素子4としてNd:YAGを用い、一方 った(例えばR.Burnham and A.D.Hays, Opt. Lett. <u>14</u>,27 19 の搭面をダイクロイックコーティング(Nd:YAGレーザ発 振放長1064mmで高反射(HR)、半導体レーザ光波長808n mで高透道 (AR)) し、その面を励起面とし、アウトブ ットミラー5とで共転器を構成する。用いたアレイ半導 体レーザ 1 は幅が100mmの活性層ストライプ?が20本5 SOμ血間隔で配列したアレイからなる。集光レンズアレ イ2 は幅500mmの分布屈折率レンズ20個からなり20本 のストライプからの出射光の各々を集光しコリメートす る。25年のレーザビームを第2のレンズ3でフォーカシ ングし一箇所に重ね合わせて、Nd:YACロッドからなる固 29 体レーゲ素子4を纏面励起する。

> このようにして橋面励起した半導体レーザ励起固体レー ザに於て、5mの半導体レーザ(波長808mm)出力でMdi:YA Gレーザ基本波(波長1064mii)出方1.50の高出力発振が 海られている。

「奥時の効果」

以上説明したとおり、本発明の如く、光緒台器として、 上記のような構成をもつ半導体レーザ励起固体レーザ は、従来のアレイ半導体レーヴでは困難であった端面励 起を可能にし、効率が高くビーム質の良い高出力の個体 レーザを実現できる。

【図面の簡単な説明】

第1回はアレイ半導体レーザの各ストライプからの出射 光を分布屈折率レンズアレイを用いて集光してコリメー トし第2のレンスでフォーカシングして一箇所に重ね台 せて光励起する半導体レーザ励起固体レーザの模式図で ある.

図中.

1……アレイ半導体レーザ

2……分布屈折率レンズアレイ

49 3……レンズ

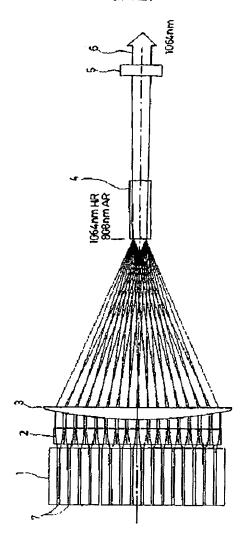
4……固体レーザ素子

5……アクトブットミラー

6……出力光

7……活性層ストライプ

【第】図】



* NOTICES *

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

CLAIMS

[Claim(s)]

[Claim 1] Array semiconductor laser excitation solid state laser which is characterized by providing the following and which condenses an array semiconductor laser output and carries out optical pumping of the solid-state-laser element A lens array which puts a distribution refractive-index lens in order corresponding to each stripe of array semiconductor laser, and condenses and collimates an array semiconductor laser output The 2nd lens used as a focusing glass for condensing each collimated stripe light collectively and carrying out end-face excitation of superposition and the solid-state-laser element at one place

[Translation done.]

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.**** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DETAILED DESCRIPTION

[Detailed Description of the Invention]

[Industrial Application]

This invention relates to the semiconductor laser excitation solid state laser which carries out optical coupling of the semiconductor laser output as the end-face light source with a well head, and carries out optical pumping of the solid-state-laser element.

[Description of the Prior Art]

Since the solid state laser using semiconductor laser as the excitation light source can attain a well head, long lasting, and a miniaturization, it attracts attention. By the end-face excitation method (for example, refer to JP,58-52889,A) in semiconductor laser excitation solid state laser which carries out optical pumping from [of solid state laser] an optical axis, by making the excitation space by semiconductor laser output light match with the space mode of an oscillation of solid state laser well, it is efficient and a single basic transverse-mode oscillation can be realized.

[Problem(s) to be Solved by the Invention]

Since the beam angle of divergence of semiconductor laser is large, it is necessary to approach semiconductor laser and to condense a condensing system, and condensing of oscillation light is not easy. It is necessary to carry out a high increase in power of the semiconductor laser for excitation for the high increase in power of semiconductor laser excitation solid state laser. Although a laser beam carries out outgoing radiation of the semiconductor laser from a stripe-like barrier layer, by single stripe laser, a limit is in an output, and in order to obtain the output beyond this, it must be made the shape of an array which put two or more stripes in order.

If it is going to use such array semiconductor laser as the excitation light source, since the width of face of an array will be crossed to a length of about 1cm Since it cannot perform narrowing down two or more beams in the shape of [one] a spot using the usual lens system at all, an end-face excitation method with sufficient excitation efficiency is not employable. It was applicable only to the side excitation method (for example). [R.Burnham and A.D.Hays, Opt.Lett. 14, 27(1989);M.KReed, W.J.Kozlovsky, R.L.Byer, G.L.Harnagel,] [and] P. Reference, such as S.Cross, Opt.Lett., and 13,204 (1988).

It was made in view of this condition, and the angle of divergence which comes out of the array semiconductor laser of a multi-stripe condenses two or more beams of large a large number, and this invention aims at offering the semiconductor laser excitation solid state laser which makes solid-state-laser output light occur efficiently so that the excitation space by semiconductor laser output light may be matched with the space mode of an oscillation of solid state laser.

[The means for solving a technical problem]

In the array semiconductor laser excitation solid state laser which condenses an array semiconductor laser output and carries out optical pumping of the solid-state-laser element as a means of this invention in order to attain the above-mentioned purpose The lens array which puts a distribution refractive-index lens in order corresponding to each stripe of array semiconductor laser, and condenses and collimates an array semiconductor laser output, the 2nd lens used as a focusing glass for condensing each collimated stripe light collectively and carrying out end-face excitation of superposition and the solid-state-laser element at one place — since — it has the becoming optical coupling machine.

[Function]

In the case of an end-face excitation method, the property of the transverse mode of semiconductor laser excitation solid state laser is decided by the configuration of the optical-pumping space in a solid-state-laser element. For this reason, in order to obtain the single basic transverse mode, it is desirable to, bring the narrowed excitation luminous-intensity distribution close to Gaussian distribution if possible, and to make the beam spot of fixed magnitude stably in a solid-state-laser element.

If the distribution refractive-index lens which is the cylinder-like optical-glass object with which a refractive index is distributed from a medial axis in the shape of radiation toward a peripheral face, and differ as an optical coupling machine of semiconductor laser excitation solid state laser is used, a large semiconductor laser light of an angle of divergence can be condensed easily.

It uses that the laser beam from each stripe can be condensed using a distribution refractive—index lens with such a property, and the outgoing radiation light from each stripe of array semiconductor laser is condensed by the distribution refractive—index lens array, and if whole light is extracted to the one beam spot with the 2nd lens and a solid—state—laser element is excited, the transverse—mode light of high quality will be obtained.

[Example]

Hereafter, this invention is explained based on an example.

Drawing 1 is a mimetic diagram of the solid state laser which condenses array semiconductor laser light and carries out end-face excitation of the solid-state-laser element. As shown in drawing 1, die clo IKKU coating (it is high transparency (AR) at Nd:YAG laser oscillation wavelength of 1064nm in high reflection (HR) and 808nm of semiconductor laser light wave length) of one end face is carried out, the field is made into an excitation side, using Nd:YAG as a solid-state-laser element 4, and a resonator consists of output mirrors 5. The used array semiconductor laser 1 consists of an array which the barrier layer stripe 7 whose width of face is 100 micrometers arranged at intervals of 20 micrometers [500]. The condenser lens array 2 consists of 20 distribution refractive-index lenses with a width of face of 500 micrometers, and condenses and collimates each of the outgoing radiation light from 20 stripes. Focusing of the 20 laser beams is carried out with the 2nd lens 3, it lays on top of one place, and end-face excitation of the solid-state-laser element 4 which consists of a Nd:YAG rod is carried out. Thus, the high power oscillation of Nd:YAG laser fundamental-wave (wavelength of 1064nm) output 1.5W is obtained with the semiconductor laser (wavelength of 808nm) output of 5W in the semiconductor laser excitation solid state laser which carried out end-face excitation.

[Effect of the Invention]

Like this invention, as an optical coupling machine, the semiconductor laser excitation solid state laser with the above configurations enables end-face excitation which was difficult in the conventional array semiconductor laser, and effectiveness can realize the solid state laser of high high power with the sufficient quality of a beam as explained above.

[Translation done.]

* NOTICES *

Japan Patent Office is not responsible for any damages caused by the use of this translation.

- 1. This document has been translated by computer. So the translation may not reflect the original precisely.
- 2.*** shows the word which can not be translated.
- 3.In the drawings, any words are not translated.

DESCRIPTION OF DRAWINGS

[Brief Description of the Drawings]

<u>Drawing 1</u> is a mimetic diagram of the semiconductor laser excitation solid state laser which condenses and collimates the outgoing radiation light from each stripe of array semiconductor laser using a distribution refractive—index lens array, and carries out focusing with the 2nd lens and which piles up and carries out optical pumping to one place.

Inside of drawing

- 1 Array semiconductor laser
- 2 Distribution refractive-index lens array
- 3 Lens
- 4 Solid-state-laser element
- 5 Output mirror
- 6 Output light
- 7 Barrier layer stripe

[Translation done.]